

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2020년 10월 22일 (22.10.2020) WIPO | PCT



(10) 국제공개번호
WO 2020/213836 A1

(51) 국제특허분류:
H01L 21/687 (2006.01) H01L 21/02 (2006.01)
H01L 21/67 (2006.01) H01L 21/3065 (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2020/003341

(22) 국제출원일: 2020년 3월 11일 (11.03.2020)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2019-0044499 2019년 4월 16일 (16.04.2019) KR

(71) 출원인: 주식회사 티씨케이 (TOKAI CARBON KOREA CO., LTD) [KR/KR]; 17602 경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71, Gyeonggi-do (KR).

(72) 발명자: 김경준 (KIM, Kyoung Jun); 16213 경기도 수원시 장안구 광교산로 148, 101동 201호, Gyeonggi-do (KR).

(74) 대리인: 특허법인 무한 (MUHANN PATENT & LAW FIRM); 06144 서울시 강남구 언주로 560, 8층, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유

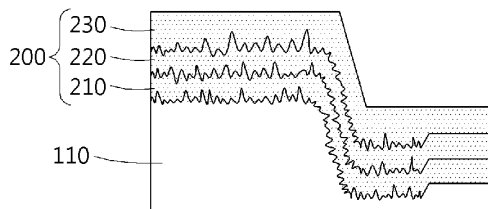
럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: SIC EDGE RING

(54) 발명의 명칭: SIC 엣지 링



(57) Abstract: The present invention relates to an edge ring among components for manufacturing semiconductors used in a semiconductor manufacturing process. The SiC edge ring of the present invention comprises: a first deposition part having a plasma-damaged portion and a non-damaged portion and comprising SiC; and a second deposition part formed on the first deposition part and comprising SiC, wherein a boundary between the damaged portion of the first deposition part and the second deposition part includes an uneven surface.

(57) 요약서: 본 발명은 반도체 제조공정에서 사용되는 반도체 제조용 부품 중 엣지 링에 관한 것으로서, 본 발명의 SiC 엣지 링은, 플라스마 손상 부분 및 미손상 부분을 가지는 SiC를 포함하는 제1 증착부; 및 상기 제1 증착부 상에 형성된 SiC를 포함하는 제2 증착부;를 포함하고, 상기 제1 증착부의 손상 부분과 상기 제2 증착부 간의 경계는 비평탄면을 포함한다.

WO 2020/213836 A1